



П А С П О Р Т

Микросхемы типа К168КТ2А, К168КТ2Б

соответствуют техническим условиям 6КО.348.079ТУ

1. Функциональное назначение: четырехканальный аналоговый переключатель, предназначенный для коммутации аналоговых сигналов постоянного и переменного тока в различных радиоэлектронных устройствах.
2. Основные электрические параметры приведены в табл. 1.

Таблица 1

Условное обозначение типа микросхемы		Основные электрические параметры			
Старое	По ГОСТ 18682-73	Динамическое сопротивление при $U_{из} = \text{минус } 15 \text{ В}$ Ом	Ток утечки стока, нА	Ток утечки истока, нА	Ток утечки затвора, нА
		$R_{дн}$	$I_{с.ут.}$	$I_{и.ут.}$	$I_{з.ут.}$
		не более	не более	не более	не более
К168КТ2А К168КТ2Б	К168КТ2А К168КТ2Б	150 150	50 50	50 50	50 50

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Значение токов утечек $I_{с.ут.}$, $I_{и.ут.}$, $I_{з.ут.}$ указаны для предельно допустимых значений напряжений между стоком и подложкой $U_{сп}$, истоком и подложкой $U_{ин}$, затвором и подложкой $U_{из}$.
2. В документации предприятий-потребителей, разработанной до введения в ЧТУ новых условных обозначений допускается сохранение старых условных обозначений.
3. Содержание драгоценных металлов: золотого 19,9014 мг, серебра 1,0751 мг.
4. Рекомендации по установке и монтажу микросхем.

4.1. Микросхемы должны устанавливаться на печатную плату после формовки выводов. Радиус изгиба равен 0,4 мм, минимальное расстояние от корпуса до центра окружности изгиба равно 1 мм.

4.2. Установку микросхем на плату и аппаратуру производить с зазором от 0 до 0,7 мм с последующей припайкой и припайкой элементов.

При установке микросхем допускается использовать прокладки из электроизоляционного материала.

4.3. Лужение выводов микросхем производить методом погружения в расплавленный припой. Температура расплавленного припоя не более 250°C. Время погружения не более 2 с. Расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм. Интервал между погружениями не менее 5 мин.

4.4. Пайку микросхем к печатной плате производить припоем ПОССу-61-0,5 ГОСТ 21931-76 с применением флюса ФКСн по ОСТ 4ГО.033.000.

4.5. Очистка от флюса проводится протиркой тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью (1:1) согласно приложению 2 в ОСТ 11.029.001-74.

4.6. При пайке микросхем одножальным паяльником:

- температура жала паяльника, °C, не более 265
- время касания каждого вывода, с, не более 3
- интервал между пайками соседних выводов, с, не менее 3
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1

Жало паяльника должно быть заземлено.

4.7. При пайке микросхем групповым паяльником:

- температура жала группового паяльника, °C, не более 265
- время воздействия (одновременно на подложку или на все выводы), с, не более 2
- расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода), мм, не менее 1
- интервал между двумя повторными пайками одной микросхемы, мин, не менее 5

Жало группового паяльника должно быть заземлено.

4.8. При обращении с микросхемами (в процессе измерения, распаковки и т. д.) все металлическое оборудование, а также инструменты должны быть заземлены. Критерием качества заземления является отсутствие высокочастотных наводок, возникающих при включении и выключении силовых установок.

4.9. При хранении, транспортировке и обращении все выводы микросхем должны быть замкнуты накоротко.

4.10. Микросхемы в блоках аппаратуры должны быть защищены четырьмя слоями бесцветного лака УР 231 ГУ-6-10-863-76 или ЭП-730 ГОСТ 20824-75.

Температура сушки лака не более +60°C. Покрытие микросхем лаком производится по ОСТ 11.ГО.014.001.

5. Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °C от минус 45 до +85
- относительная влажность воздуха при температуре +25°C, %, не более 98
- вибрации в диапазоне частот от 1 до 600 Гц с ускорением, g, не более 10
- многочисленные удары с ускорением, g, не более 75
- линейные (центробежные) ускорения, g, не более 25

Таблица 2

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		К168КТ2А	К168КТ2Б
		не более	не более
Напряжение между стоком и подложкой, В	Цсп	10	15
Напряжение между истоком и подложкой, В	Цип	10	15
Напряжение между затвором и подложкой, В	Цзп	30	30
Постоянный коммутируемый ток, мА	Ikom	20	20
Мощность, рассеиваемая микросхемой при температуре окружающей среды до +85°C, мВт	P макс	100	100

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальный импульсный коммутируемый ток определяется исходя из максимальной мощности рассеивания и предельных электрических режимов.

6. Время гарантийной наработки 11000 ч.

7. Срок хранения 6 лет.

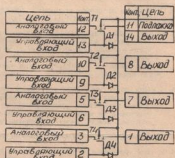
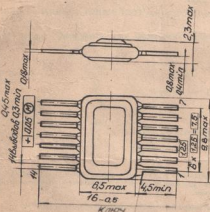
8. Гарантия предприятия-изготовителя:

— предприятие-изготовитель гарантирует соответствие всех поставленных микросхем требованиям общих и частных технических условий и производит безвозмездную поставку новых микросхем или возмещает стоимость микросхем (согласно действующим прецедентам), если в течение установленного срока хранения или времени гарантийной наработки будет установлено, что микросхемы не удовлетворяют существующим требованиям общих и частных технических условий при соблюдении потребителем режимов эксплуатации и правил хранения, а также указывает и рекомендаций по применению и эксплуатации микросхем. Кроме того, поставщик несет материальную ответственность путем уплаты штрафа в размере 15% стоимости микросхем и возмещения транспортных расходов по их пересылке.

9. Гарантия исчисляется со дня приема микросхем ОТК.

10. Габаритный чертеж.

12. Схема электрическая принципиальная



11. Масса не более 0,4 г.

13. Дата выпуска. 14.07.82

Штамп ОТК

